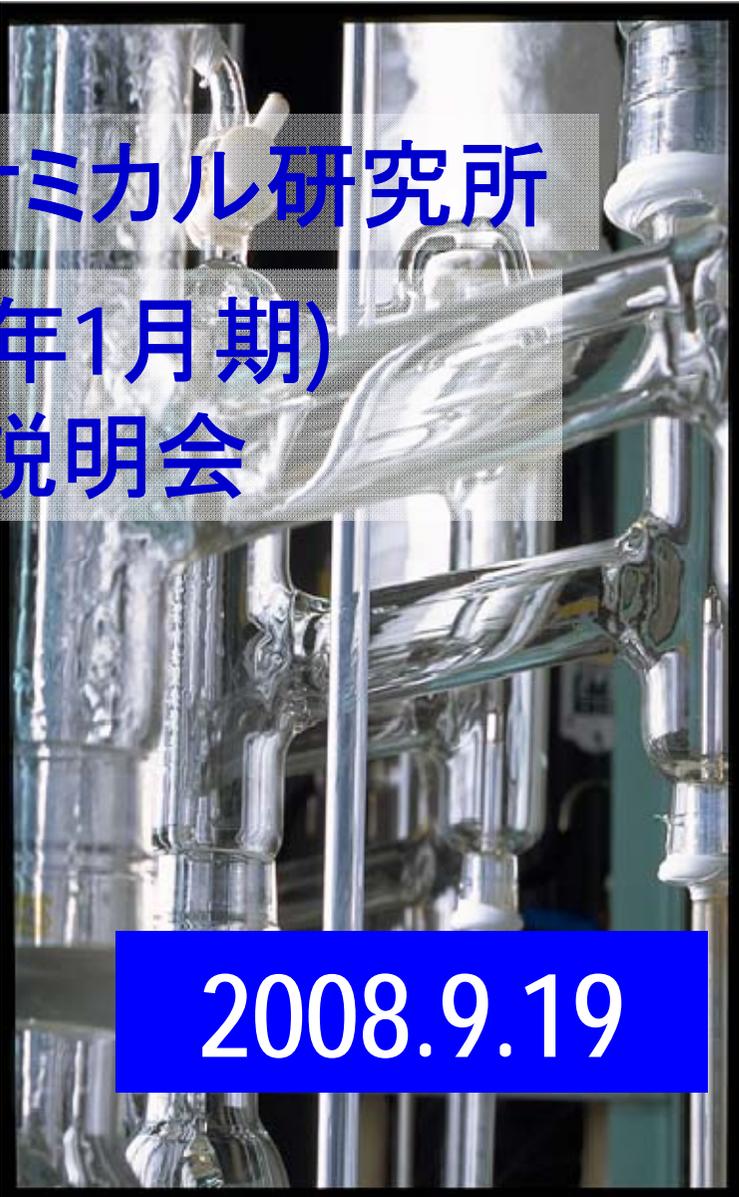


# 株式会社 トリケミカル研究所

## 第31期(2009年1月期) 中間決算説明会

大阪証券取引所ヘラクレス市場  
証券コード:4369



2008.9.19

## 目次

1. 2009年1月期中間期実績	3	2. 2009年1月期見通し及び戦略	11
中間決算総括(連結)	4	2009年1月期通期見通し(連結)	12
販売実績	5	売上予想分析(ユーザー地域別)	13
連結損益計算書	6	売上予想分析(製品用途別)	14
連結貸借対照表	7	売上予想分析(シリコン半導体)	15
連結キャッシュ・フロー	8	2009年1月期業績見込みの要因と課題	16
売上分析(ユーザー地域別)	9	2009年1月期通期戦略(1)	17
売上分析(製品用途別)	10	2009年1月期通期戦略(2)	18
		その他のトピック(1)	19
		その他のトピック(2)	20
		その他のトピック(3)	21
		3. 添付資料	22

この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営判断に基づいております。  
あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

## 1.2009年1月期中間期実績

## 中間決算総括(連結)

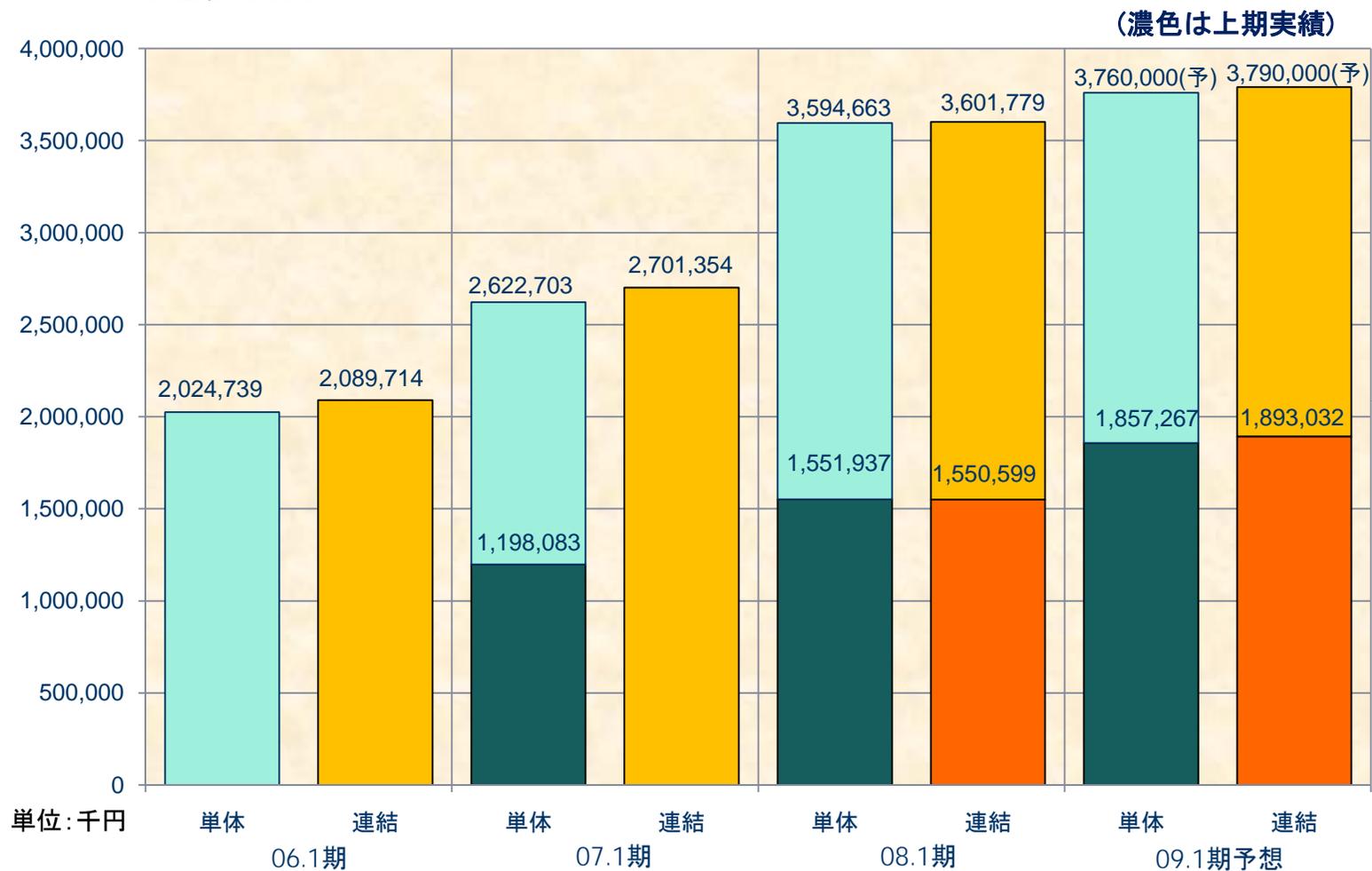
売上高: 1,893百万円 前年同期比 122.1% 計画比 100.2%

**!シリコン半導体向け売り上げ2割増**  
**!台湾向け売上4割増**

営業利益:	372百万円	前年同期比	168.1%	計画比	106.5%
経常利益:	389百万円	前年同期比	194.6%	計画比	114.7%
当期純利益:	232百万円	前年同期比	197.9%	計画比	113.4%

**! 製造原価の低減により計画を若干上回る**

## 販売実績



**! 09.1期は前期比約5%の成長を目論む**

## 連結損益計算書

	08/1期中間期	09/1期中間期	前年同期比		計画比 増減率
			増減額	増減率	
売上高	1,550,599	1,893,032	342,433	22.1%	0.2%
営業利益	221,750	372,683	150,932	68.1%	6.5%
経常利益	200,358	389,940	189,581	94.6%	14.7%
当期純利益	117,406	232,392	114,985	97.9%	13.4%

単位：千円

**！ 営業利益率：前期14.3%→19.7%に上昇**

**！ 売上増・製造原価低減等による原価率改善  
(前年同期54.6%→48.3%)**

## 連結貸借対照表

	08/1期末	09/1期中間期末	増減額
流動資産	2,057,043	2,043,136	-13,906
固定資産	1,746,797	1,906,069	159,271
資産合計	3,803,841	3,949,206	145,364
流動負債	1,372,630	1,392,778	20,148
固定負債	186,626	135,536	-51,089
負債合計	1,559,257	1,528,315	-30,941
株主資本	2,239,968	2,417,889	177,921
評価・換算差額等	4,615	3,000	-1,615
純資産合計	2,244,584	2,420,890	176,306
負債純資産合計	3,803,841	3,949,206	145,364

単位：千円

### 主な増減要因

資産		
<増加>	第二工場建設等による有形固定資産の増加	151,936
負債		
<減少>	長期借入金の返済による減少	55,232
純資産		
<増加>	純利益の計上による利益剰余金の増加	177,921

## 連結キャッシュ・フロー

	08/1期中間期	09/1期中間期	増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	125,066	338,046	212,979
投資活動による キャッシュ・フロー	-83,894	-249,999	-166,104
財務活動による キャッシュ・フロー	13,076	-29,587	-42,663
現金及び現金 同等物の増減額	55,011	56,347	1,335
現金及び現金同等 物の中間期末残高	158,772	186,875	28,103

単位：千円

### 主な増減要因

#### 営業CF

<増加>	税前純利益計上	389,940
<減少>	法人税等の支払	208,396

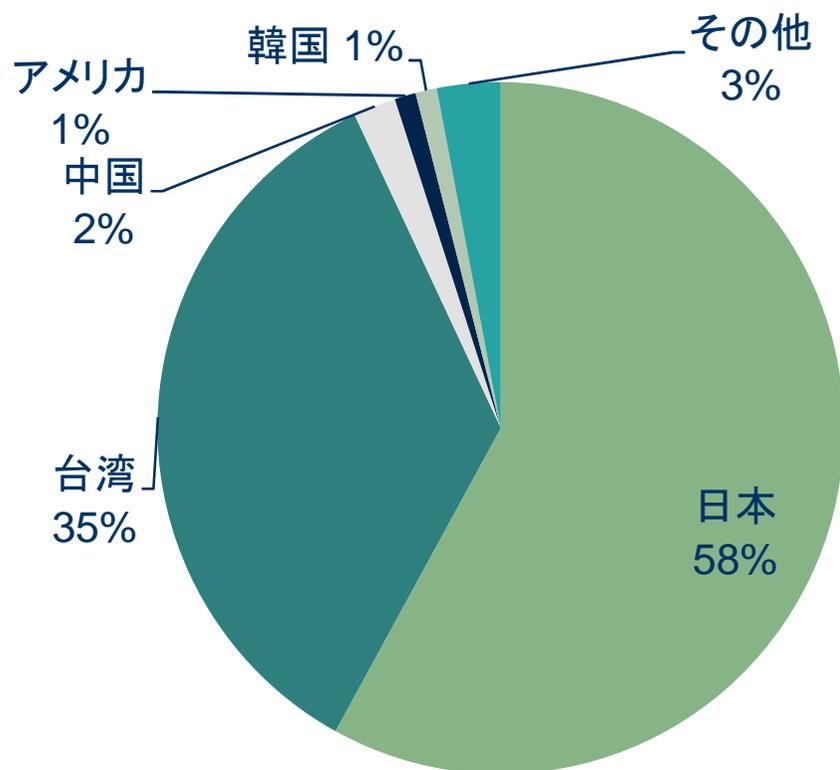
#### 投資CF

<減少>	有形固定資産の取得	249,397
------	-----------	---------

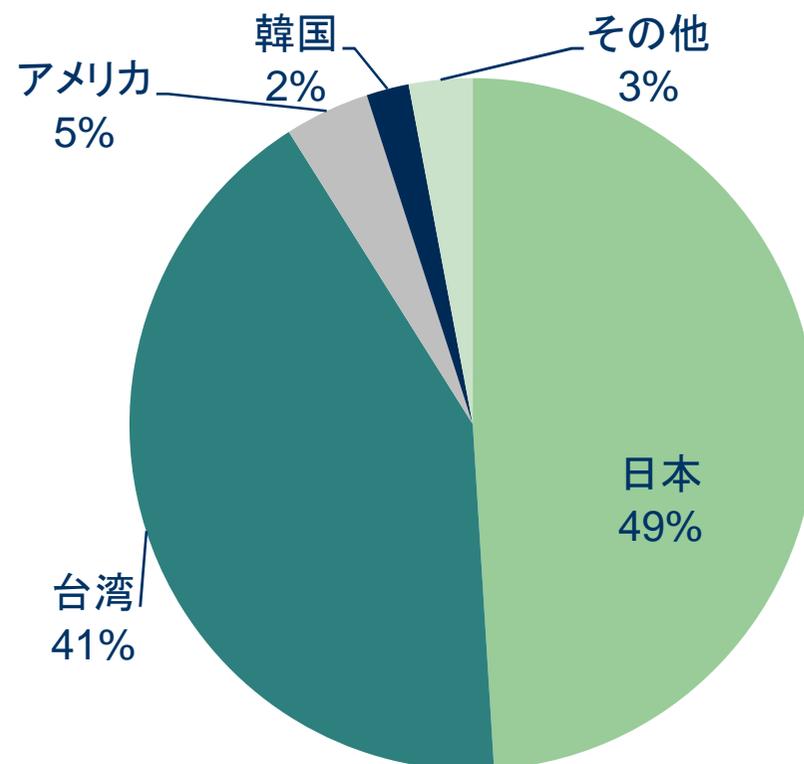
#### 財務CF

<減少>	配当金の支払	54,355
------	--------	--------

## 売上分析(ユーザー地域別)



08/1期中間期

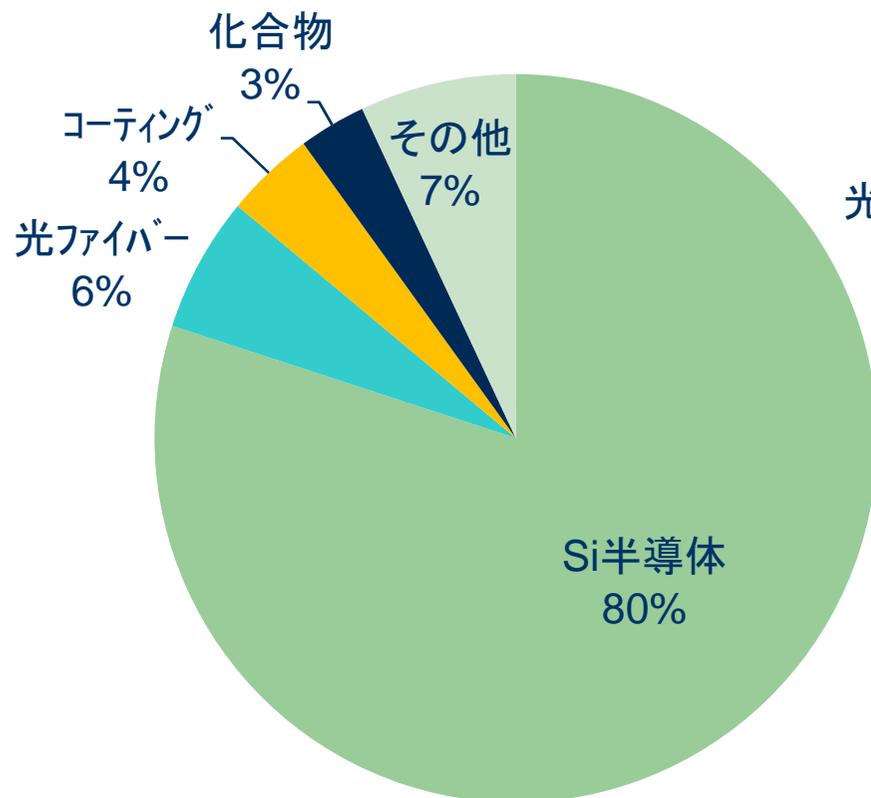


09/1期中間期

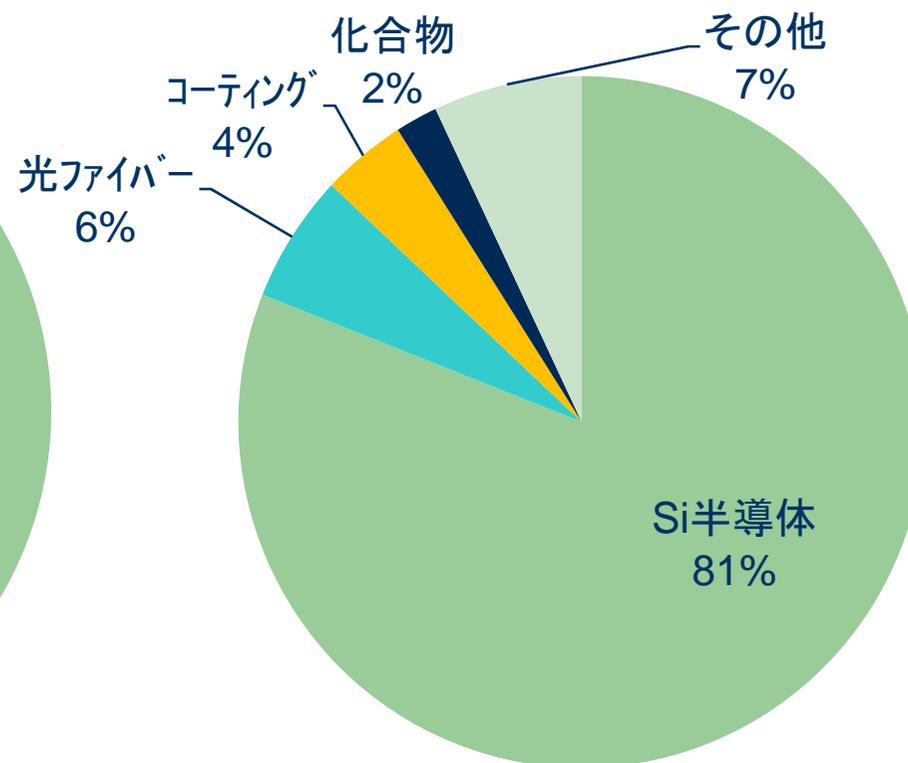
**！台湾市場における販売量が増加**

※当社推定による概算値

## 売上分析(製品用途別)



08/1期中間期



09/1期中間期

**！ 全ての分野で概ね堅調に推移**

※当社推定による概算値

## 2. 2009年1月期見通し及び戦略

## 2009年1月期通期見通し(連結)

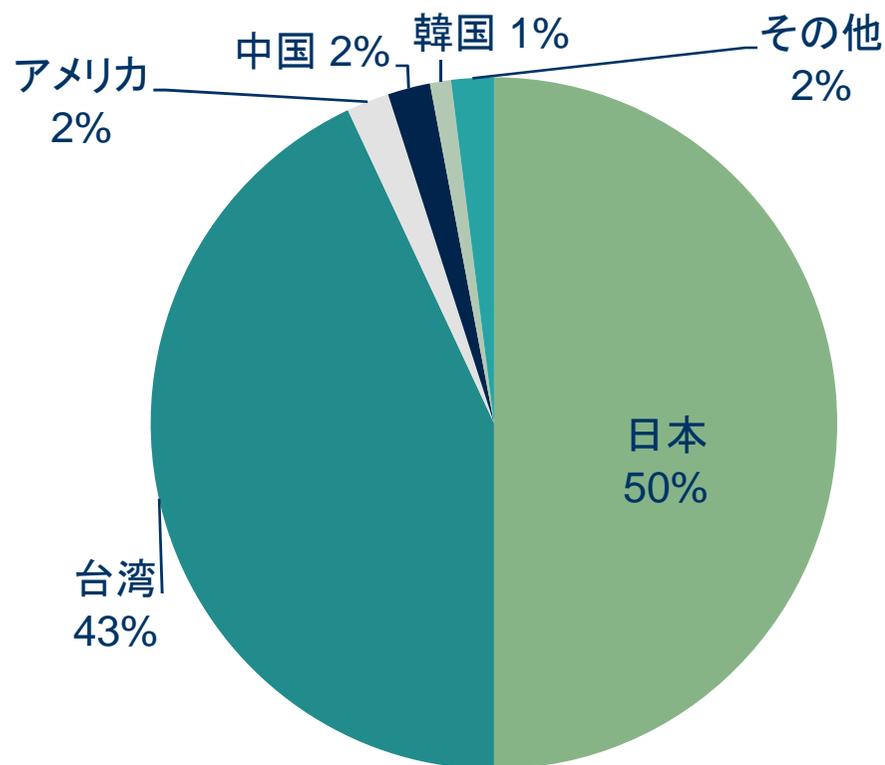
	08年1月期	09年1月期 中間期	09年1月期 (見込)	前期比 (見込)
売上高	3,601,779	1,893,032	3,790,000	105.2%
営業利益	686,622	372,683	740,000	107.8%
経常利益	628,113	389,940	730,000	116.2%
当期純利益	369,798	232,392	440,000	119.0%

金額単位：千円

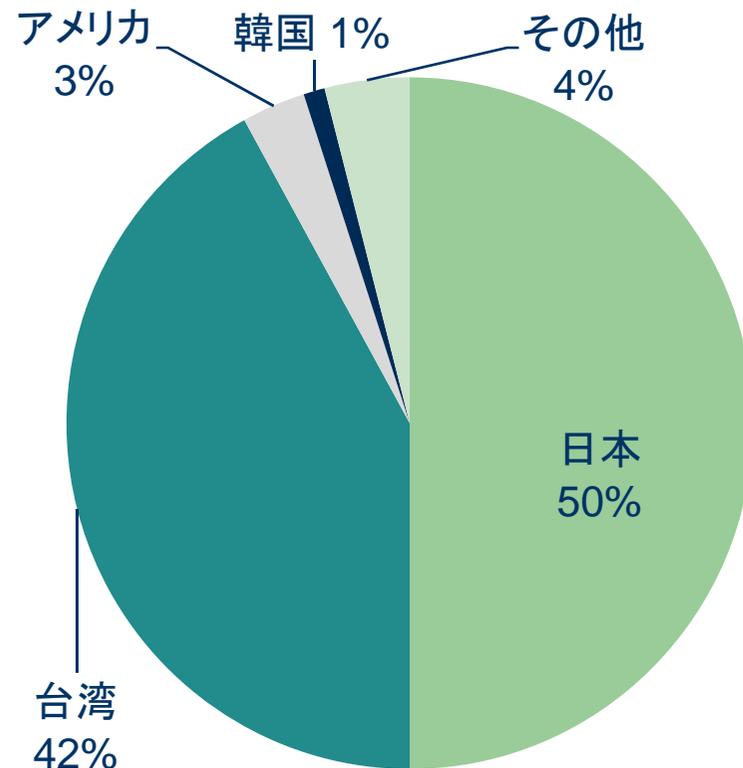
**！ 前期実績を売上で5%、営業利益で8%程度上回る見通し**

## 売上予想分析(ユーザー地域別)

08/1月期



09/1月期予想

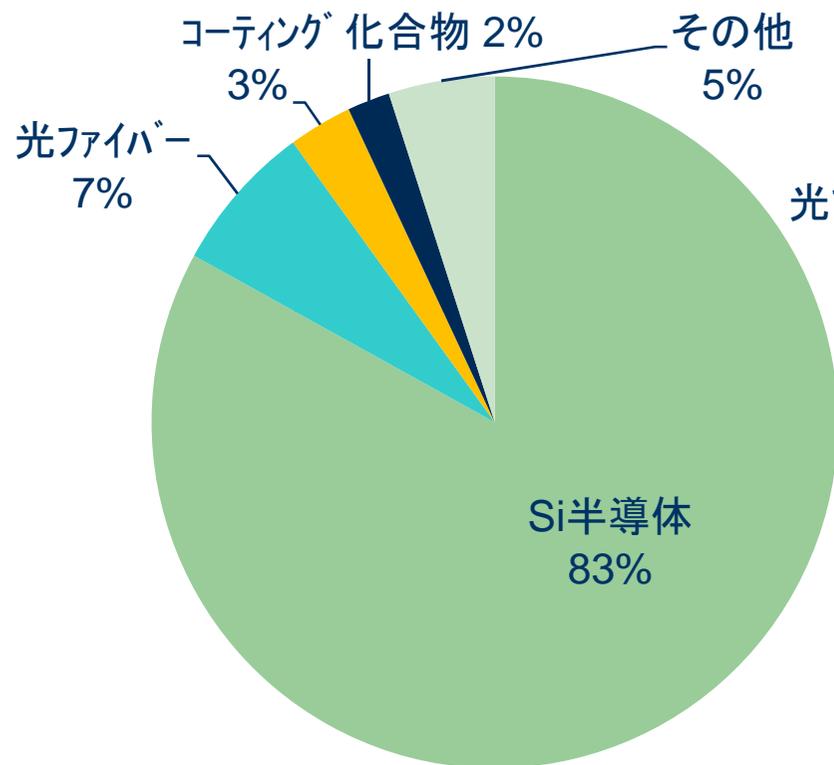


**！地域別の構成に大幅な変動はなし**

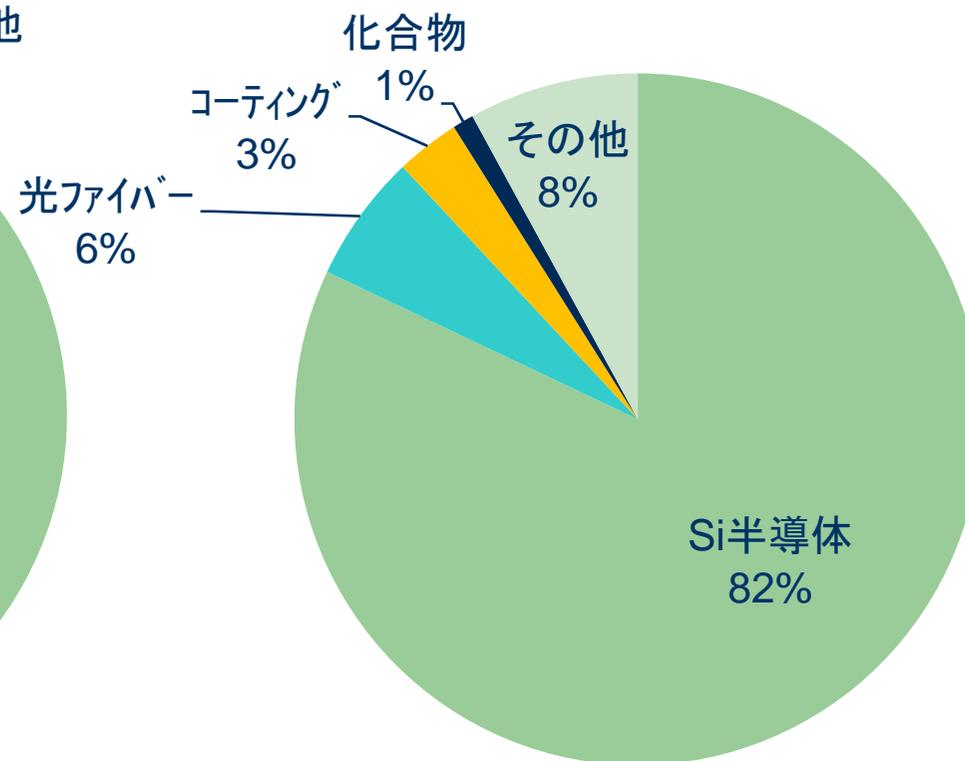
※当社推定による概算値。

## 売上予想分析(製品用途別)

08/1月期



09/1月期予想

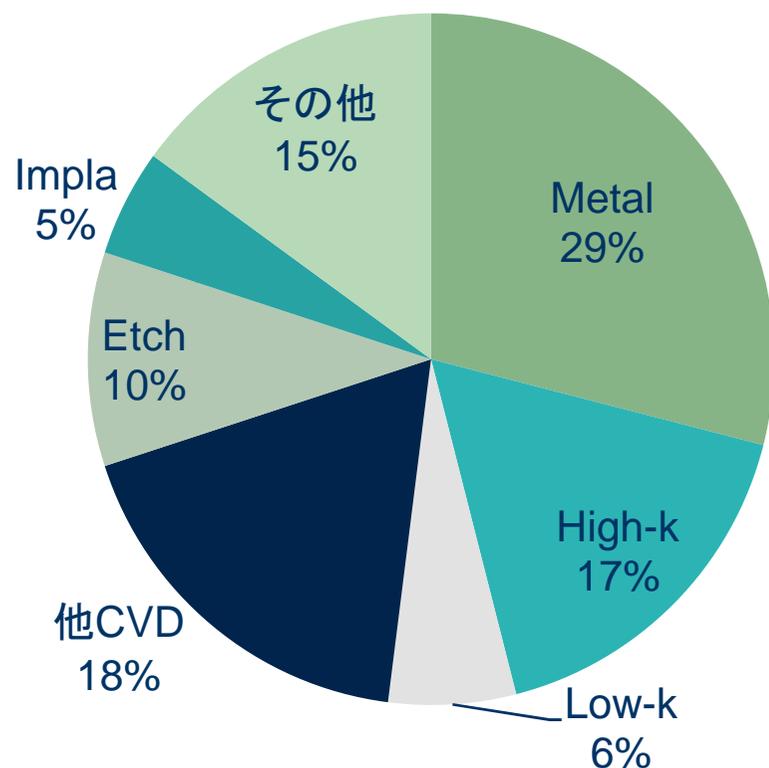


**！ 極端な変動はないもののその他分野が増加の見込み**

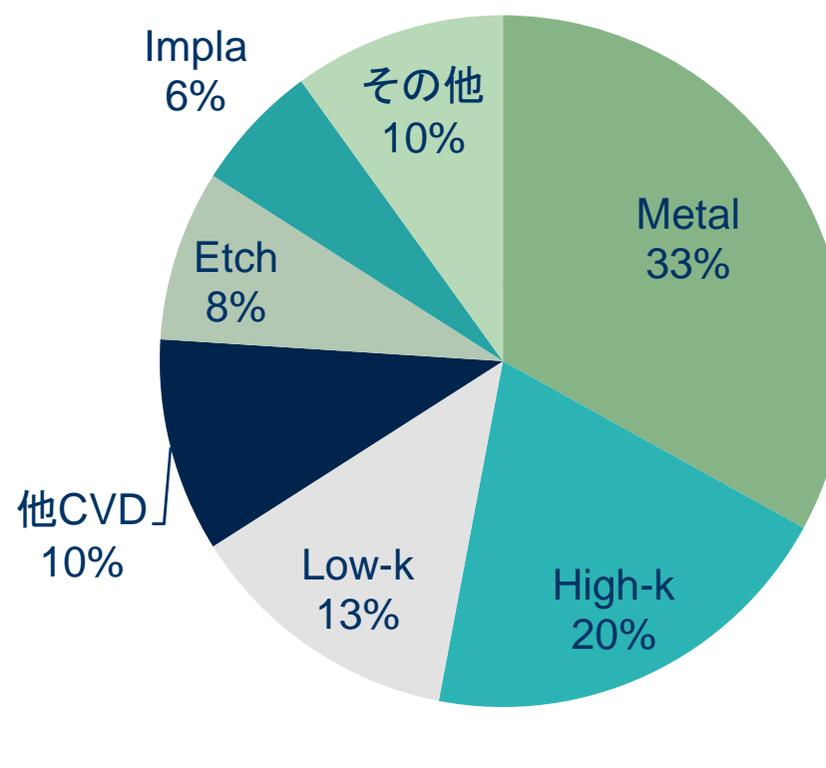
※当社推定による概算値。

## 売上予想分析(シリコン半導体)

08/1月期



09/1月期予想



**！ 先端半導体向け材料の伸びに期待**

※当社推定による概算値。

## 2009年1月期業績見込みの要因と課題

### ・売上

#### 要因

- ・先端半導体向け材料(High-k・バリアメタル等)の販売増
- ・太陽電池向け等材料の拡販に伴う業績向上

#### 課題

- ・価格面・供給過剰感等、半導体業界全体に不透明感。

### ・利益

#### 要因

- ・製造原価低減への取り組み、スケールメリットの顕在化

#### 課題

- ・最終製品(=半導体)の価格下落に対して、戦略的かつ強固な利益創出体制の構築

## 2009年1月期通期戦略(1)

### 基本戦略

業界の動向を注視しながらも、来期以降の業績の足場固め

#### ・販売戦略

今期中の半導体メーカーの新ライン・工場立ち上げはほぼ皆無



- ・主に海外向け新規商権の獲得
- ・他業種への拡販
- ・高付加価値の最先端材料の販売への注力

## 2009年1月期通期戦略(2)

### ・製造及び開発戦略

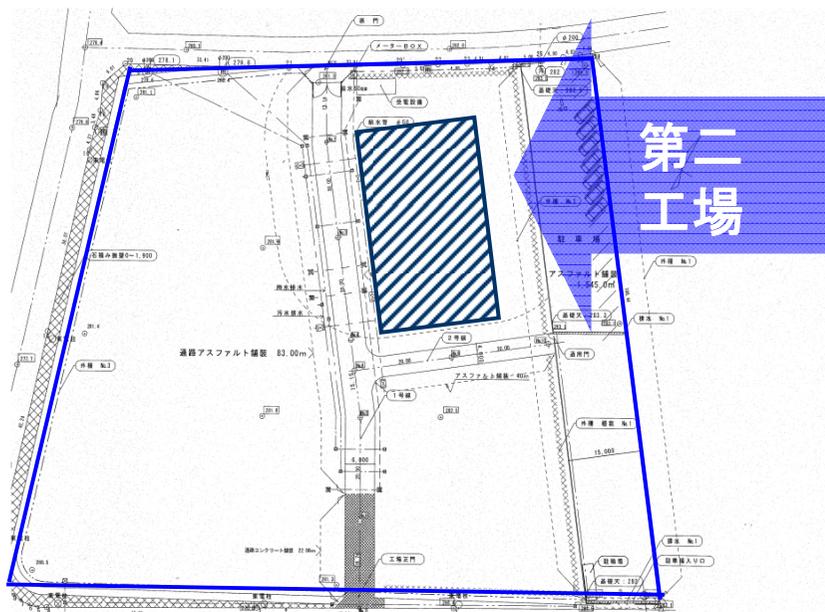
外部環境の変化に耐えうる強固な体制の構築



1. 開発スピードを加速し、新規製品を早期かつ  
コンスタントにリリース
2. 製造ラインの効率化・省力化による利益創出体制の確立
3. 上野原第二工場竣工後可能な限り早く製造活動を行  
うための準備を加速

## その他のトピック(1)

### 上野原第二工場建設



- ・本年12月竣工に向け予定通りの進捗
- ・「中量生産」に対応し、生産の合理化・成長へ向けての販売量拡大を目論む

・来期以降の業績向上の源泉



## その他のトピック(2)

### ISO14001取得

- ・環境マネジメントに関する国際認証ISO14001を取得(7月)

### 環境方針

当社は化学物質が環境に与える影響の大きさを正しく認識し、顧客・従業員の安全性向上や健康増進を常に念頭に置き、かつ、「環境保全活動への取り組み」を経営の最重要課題の一つと位置づけ、事業活動を行ってまいります。



## その他のトピック(3)

### 新株予約権の行使による資本の増加

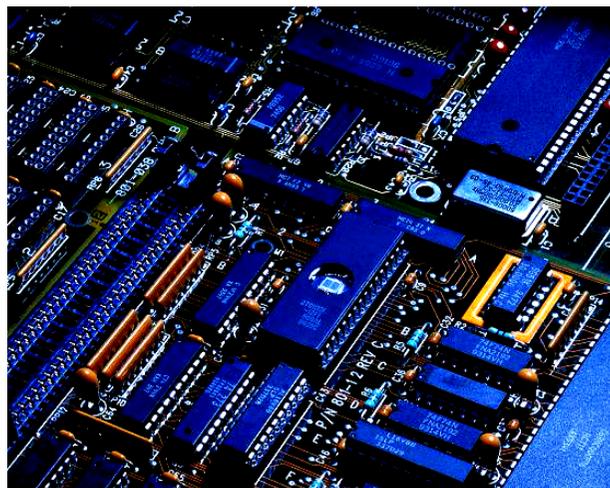
権利行使日	平成20年9月5日	
権利行使数(株数)	35,000個(350,000株)	
権利行使者	JSR株式会社	
株券等の種類	普通株式	
	権利行使前	権利行使後
資本金(円)	706,682,800	741,682,800
発行済株式数	6,810,160	7,160,160

## 3. 添付資料

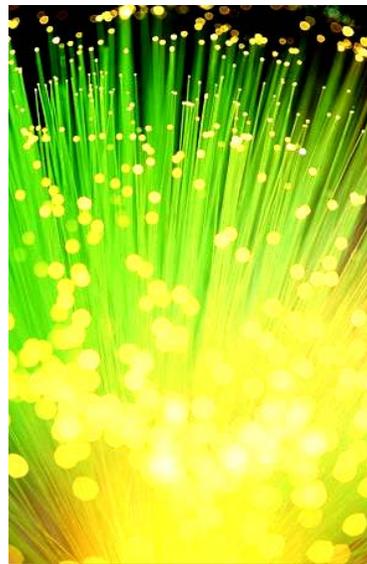
## 当社の事業内容

純度99.9999%(6N)以上の  
高付加価値化学薬品  
“**ウルトラファインケミカル**”  
の研究・開発・製造・販売

## 当社製品の主な用途



半導体



光ファイバー



太陽電池

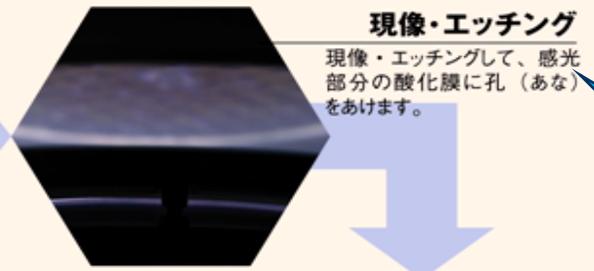
■ 半導体製造工程

■ 前工程



前工程では、ウェハ上に多くの回路パターンを作り、切り分けします。

■ 前工程のうちトリケミカル製品が用いられる工程



**現像・エッチング**  
現像・エッチングして、感光部分の酸化膜に孔（あな）をあけます。



**イオン注入**  
酸化膜の孔からイオンを注入すると、その部分が活発な半導体になります。



**メタライズ**  
ウェハの表面にアルミニウムで配線をします。

■ 後工程



後工程では、切り分けたチップを固定して結び半導体を作ります。

当社の提供する  
主な超高純度ガス・  
ケミカル

エッチング材料  
総売上の約10%  
(08年1月期実績)

イオン注入用材料  
総売上の約5%  
(08年1月期実績)

配線用材料  
(CVD材料等)  
総売上の約70%  
(08年1月期実績)

## 半導体産業における当社の役割

### 半導体業界の要求

1工場で500種以上の  
化学薬品を使用

性能向上のための  
新規プロセス  
(=薬品)の模索

半導体微細化の  
ための薬品純度  
向上要求



2,000種類を超える  
商品ラインナップ



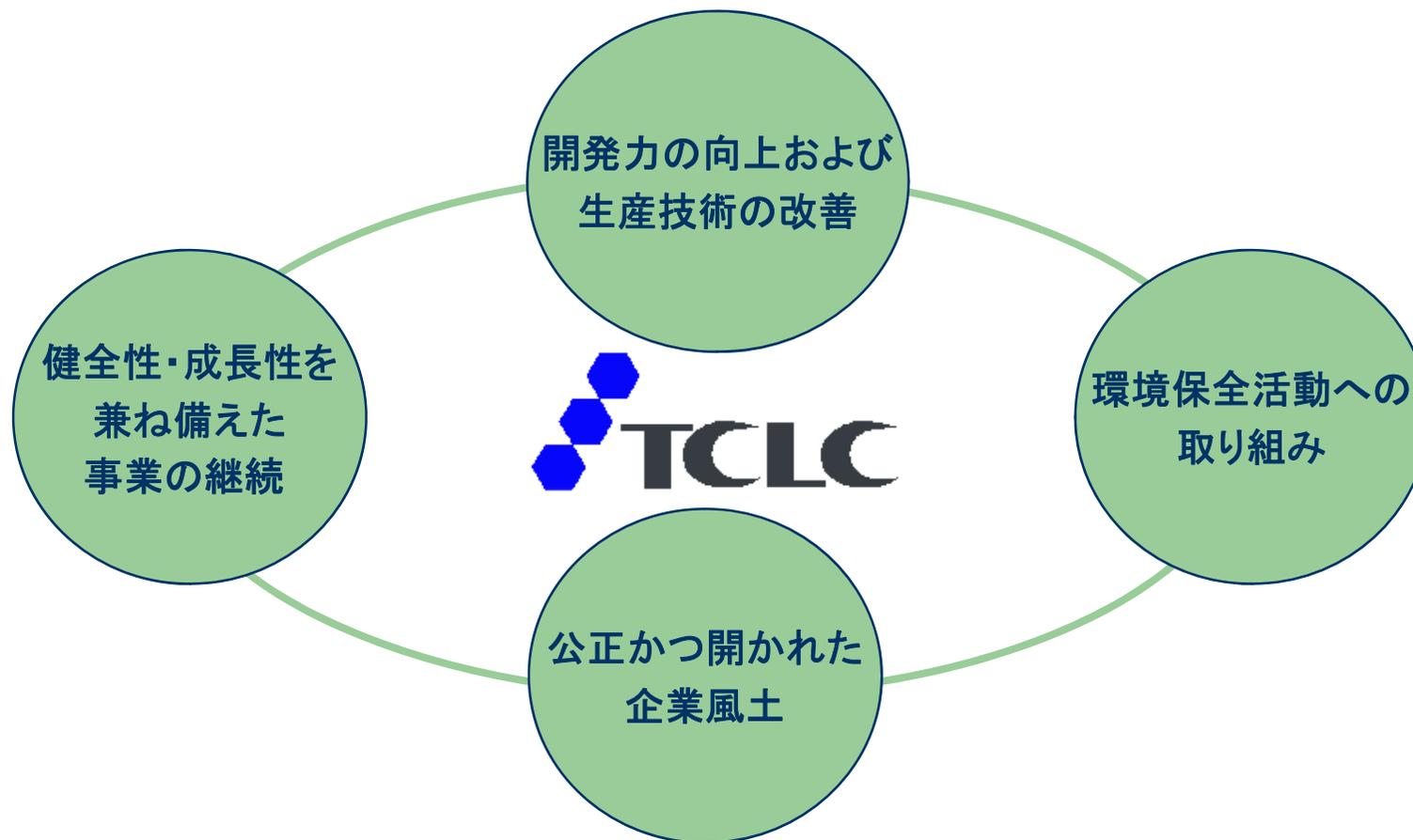
“ウルトラ  
ファインケミカル”

ミリグラム～トンまでの  
オーダーに対応可能

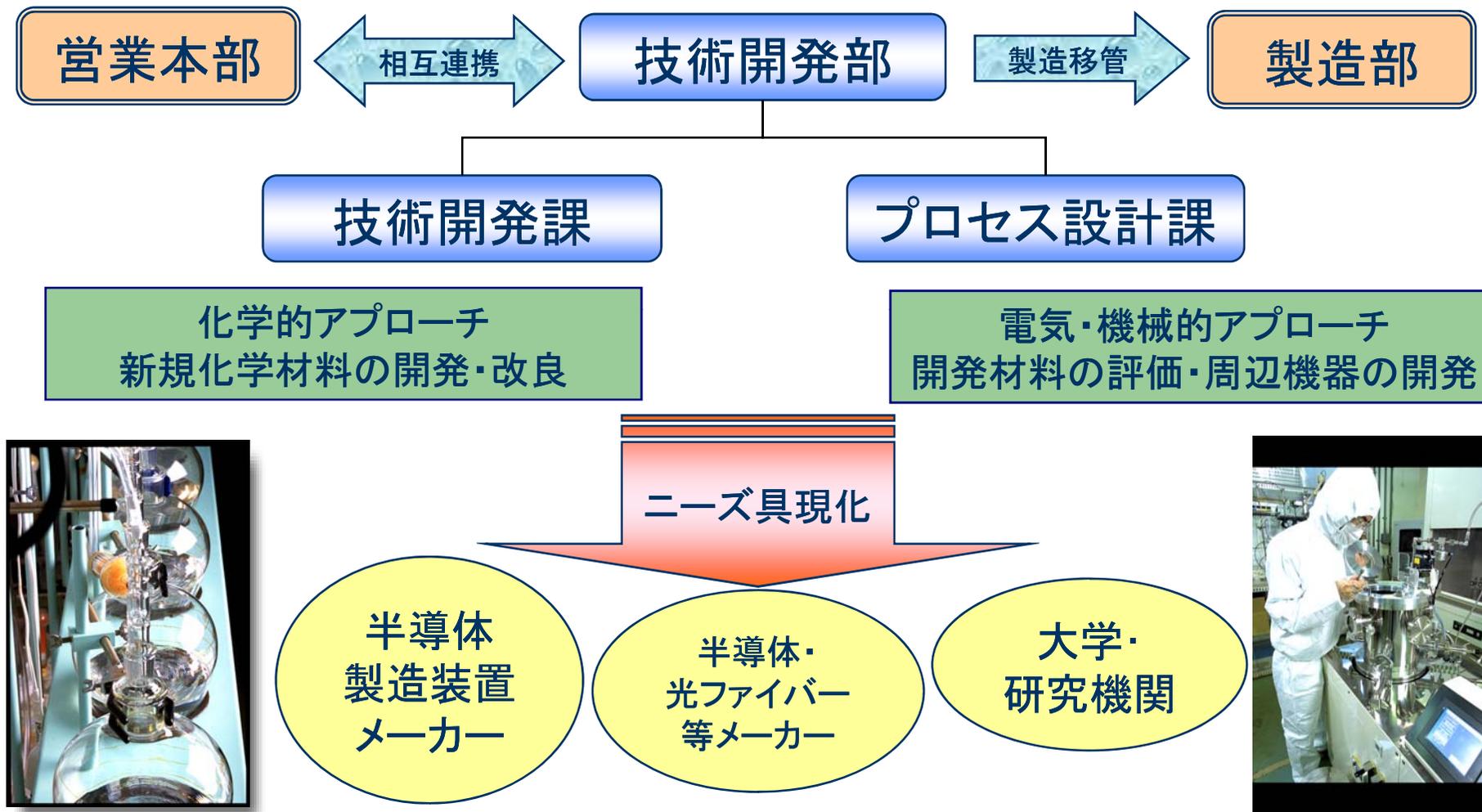
半導体製造プロセスに  
対するノウハウ

## 経営理念

「当社は科学技術を通じて最先端テクノロジーの発展に貢献し、  
人々に『ゆとり創造』を実現する」

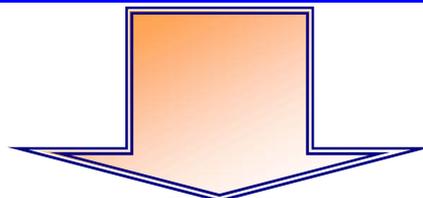


## 研究開発体制



## 研究開発の特長

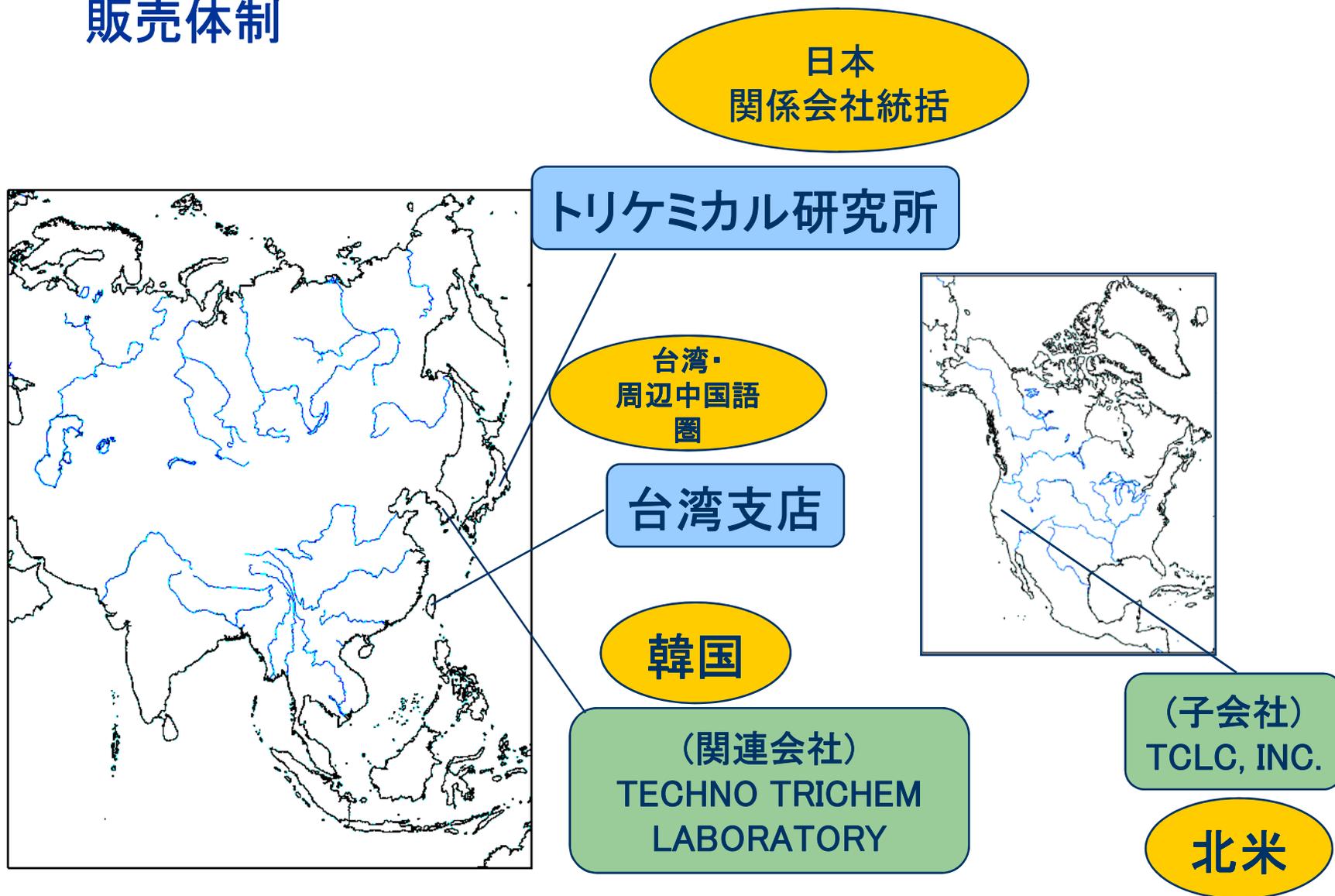
1. 営業・開発・製造一体型クイックレスポンス
2. 技術開発部は半数以上が博士・修士の化学者集団
3. 特許件数90件(出願中含む)
4. 大学・研究機関との進行中共同研究10件以上
5. 売上高の10%程度を研究開発費に充当



- ・的確な開発テーマ設定可能
- ・難易度の高いテーマにも対応可能

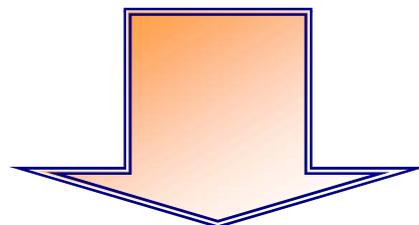
→ 多様なユーザーニーズに対応

## 販売体制



## 販売体制の特長

1. 営業・開発・製造一体型クイックレスポンス
2. 営業スタッフの大半は当社での製造・開発経験を持つ化学者集団
3. 半導体・光ファイバーの製造プロセスも熟知



- ・ ユーザーニーズに商談時に即応
- ・ 開発部門に的確なフィードバック
- ・ 積極的な提案型営業

→ **高い顧客満足度を実現**



お問合せ先 : [homepageinfo2@trichemical.com](mailto:homepageinfo2@trichemical.com)